

ИК ДИОДЫ И ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

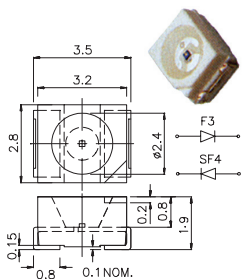


ИНФРАКРАСНЫЕ ДИОДЫ

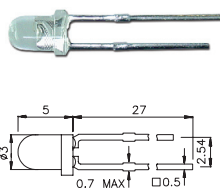
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

КМ 4457 F3 C
1 2 3 4

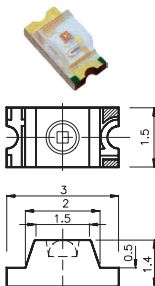
- Тип
- Размер, Д x Ш, мм
4455=4,4 x 5,7
- Длина волны
F3 - 940 нм
SF4 - 880 нм
- Тип линзы
BT - голубая прозрачная
C - бесцветная



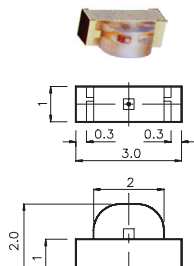
KA-3528
3.5 x 2.8 мм



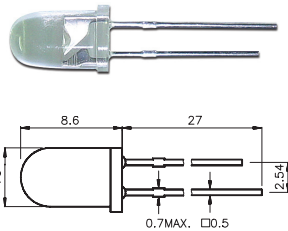
L-34
Ø = 3 мм



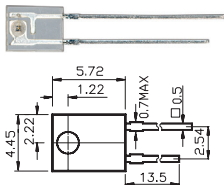
KPL-3015
3.0 x 1.5 x 1.4 мм
(1106)



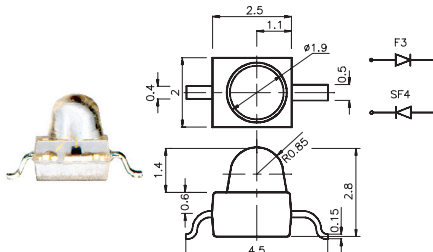
KPA-3010
3.0 x 1.0 x 2.0 мм
(1104)



L-53
Ø = 5 мм



KM-4457F3C
4.5 x 5.7 x 1.5 мм



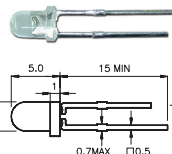
KM-2520
Ø = 2 мм

ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

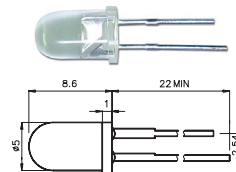
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

КР 3216P3 C
1 2 3

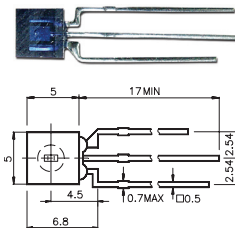
- Тип
- Размер, мм
- Тип линзы: BT - голубая прозрачная, C - бесцветная.



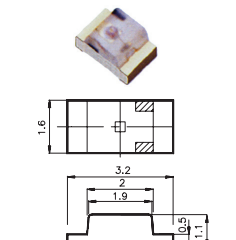
L-32P3C
Ø = 3 мм
Iтемн. = 100 нА



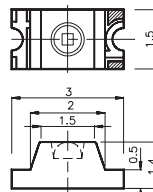
L-53P3C
Ø = 5 мм
Iтемн. = 100 нА



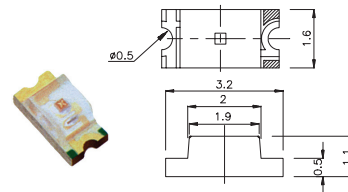
L-610MP4BT/BD
п-р-п транзистор
5 x 5 x 3 мм



KP-3216P3C
3.2 x 1.6 x 1.1 мм
(1206)



KP-3015P3C
3.0 x 1.5 x 1.4 мм
(1106)



KPC-3216
3.2 x 1.6 мм

ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

TS A L 4 4 00
1 2 3 4 5 6

- Тип: излучающий диод ИК диапазона.
- Серия
H - высокоэффективные 860 нм
A - мощные 940 нм
- Длина волны и технология изготовления
A - 860 нм, GaAlAs
L - 940 нм, GaAlAs/GaAs
- Исполнение корпуса
3 - 3 мм
4 - 3 мм
5 - 5 мм
6 - 5 мм
- Порядковый номер разработки
- Бин яркости

* Примечания: исполнение корпуса №7 для 940 нм - бесцветное прозрачное, корпуса №3, 4, 5, 6 - голубые прозрачные.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

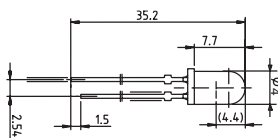


Рис. 1

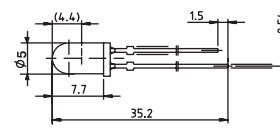


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Угол излучения, 2θ ^{1/2} , °	Длина волны, нм	Мощность излучения		Прямое падение напряжения		Время срабатывания, нс	Рисунок
			мВт/гр	при токе, mA	В	при прямом токе, mA		
TSAL4400	50	940	30	100	1.35	100	800	1
TSAL5100	20		130					2
TSAL5300	44		45					1
TSAL6200	34		60					2
TSHA4401	40	860	30	100	1.5	100	300	1
TSHA5203	24		65					2
TSHA5503	48		35					1